

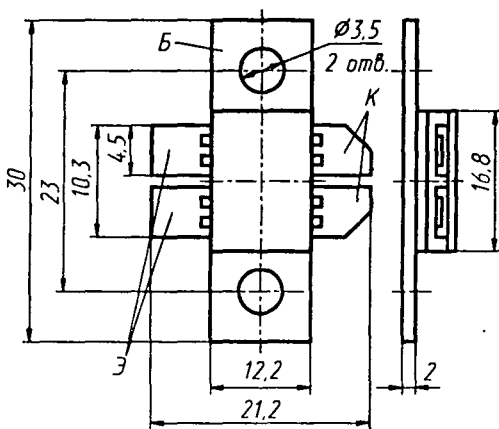
A718A, A718Б, A718B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ генераторные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности, автогенераторах и умножителях частоты в схеме с общей базой в непрерывном и импульсном режиме в диапазоне частот 0,9...1,45 ГГц. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Допускается нанесение маркировки на этикетке или на упаковочной таре, при этом маркировка на транзистор не наносится.

Масса транзистора не более 20 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

A718(A-B)



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{КБ} = 28$ В,

$K_{y, p} = 6$ дБ, не менее:

A718A на $f = 1,3$ ГГц, $\eta_K = 40\%$ 75 Вт

A718Б на $f = 1,3$ ГГц, $\eta_K = 45\%$ 75 Вт

A718B на $f = 0,96; 1,1; 1,22$ ГГц, $\eta_K = 45\%$ 60 Вт

Импульсная выходная мощность на $f = 1,2;$

$1,3; 1,4$ ГГц при $U_{КБ} = 32$ В, $K_{y, p} = 6$ дБ,

$\eta_K = 45\%$, $t_{и} = 300$ мкс, $Q = 5$ для A718Б 75 Вт

Коэффициент усиления по мощности

при $U_{КБ} = 28$ В в непрерывном режиме

и $U_{КБ} = 32$ В в импульсном режиме, не менее:

A718A на $f = 1,3$ ГГц, $\eta_K = 40\%$ 6 дБ

A718B на $f = 1,3$ ГГц, $\eta_k = 45\%$	6 дБ
A718B на $f = 0,96; 1,1; 1,22$ ГГц, $\eta_k = 45\%$	6 дБ
A718B на $f = 1,2; 1,3; 1,4$ ГГц, $\eta_k = 45\%$, $t_{и} = 300$ мкс, $Q = 5$	6 дБ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 50$ В, не более	150 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 3,5$ В, не более	50 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания:	
в непрерывном режиме	28 В
в радиоимпульсном режиме при $t_{и} = 1$ мс, $Q = 10$ или $t_{и} = 400$ мкс, $Q = 5$	32 В
в радиоимпульсном режиме при $t_{и} = 20$ мкс, $Q = 10$	35 В
Постоянное напряжение коллектор—база ¹ при $T_k = +25...+125$ °С	50 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	3,5 В
Потенциал статического электричества	1000 В
Постоянная составляющая коллекторного тока в динамическом режиме	7,5 А
Импульсный ток коллектора:	
при $t_{и} = 20$ мкс, $Q = 10$	15 А
при $t_{и} = 1$ мс, $Q = 10$ или $t_{и} = 400$ мкс, $Q = 5$	10 А
Постоянная составляющая тока базы в дина- мическом режиме	3 А
Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при $T_k = -60...+25$ °С	130 Вт
Температура окружающей среды	$-60...T_k =$ $= +125$ °С

¹ При T_k от $+25$ до -60 °С $U_{кб, макс}$ снижается линейно до 45 В.

Применение транзисторов в статическом режиме, в том числе в режиме класса «А» не допускается.

При установке в аппаратуру транзистор должен прижиматься к теплоотводу. Шероховатость контактирующей поверхности теплоотвода должна быть не более 1,6 мкм, неплоскостность не более 0,01 мм. Рекомендуется для улучшения отвода тепла от корпуса транзистора применение мягкой прокладки из сплава индий—олово с содержанием индия 20%. При этом для обеспечения лучшего теплового контакта рекомендуется под края фланца, снаружи от винтов, помещать

прокладку из твердого металла, например, из медной фольги. Ориентировочная толщина твердой прокладки 20...30 мкм, мягкой 20...30 мкм. Во избежание растрескивания керамики не допускается применение мягкой прокладки без использования твердой прокладки.

Расстояние от корпуса до начала изгиба, лужения и пайки не менее 3 мм, температура припоя $+260 \pm 5$ °С. Допускается пайка выводов на расстоянии 1,5 мм от корпуса, при этом температура припоя не должна превышать $+150$ °С. Время пайки не более 3 с. Допускается сварка выводов. Допускается обрезать и изгибать выводы на расстоянии 1,5 мм от корпуса. Допустимое число перепаек транзистора — 3.